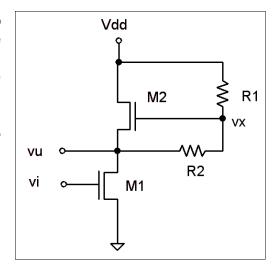
PROVA SCRITTA DI ELETTRONICA 12 GIUGNO 2008

1) Nel circuito in figura, i transistori MOS sono caratterizzati dalle tensioni di soglia $V_{Tn}=V_{Tn1}=V_{Tn2}$ e dai coefficienti β_{n1} , β_{n2} .

Si determinino i margini d'immunità ai disturbi (N_{MH} e N_{ML}) della rete.

 V_{dd} = 3.5 V, V_{Tn} = 0.5 V, $β_{n1}$ = 5mA/V², $β_{n2}$ = 0.5 mA/V², R1=5 kΩ, R2=10 kΩ.



2) Si progetti una rete FCMOS in grado di realizzare la funzione logica:

$$Y = \overline{A \cdot (B \cdot C + D \cdot (E + F))}$$

assumendo che ciascuna variabile sia rappresentata in logica positiva da una tensione $(V_Y,\,V_A,\,...,\,V_F)$ con escursione $0\text{-}V_{dd}$.

Tutti i transistori delle rete di *pull-down* abbiano lo stesso coefficiente β_n , mentre i transistori di pull-up abbiano coefficiente β_p . Sia inoltre $V_{Tn}=|V_{Tp}|=V_{T}$. Si determinino β_n e β_p in modo che:

- Il tempo di propagazione t_{P,LH} nel caso peggiore sia pari a 3 volte il tempo di propagazione t_{P,HL} nel caso migliore;
- In corrispondenza della contemporanea transizione di tutti i segnali di ingresso dal valore basso (0) al valore alto (V_{DD}), la corrente massima di corto circuito sia pari a 1 mA. A questo scopo si trascuri la corrente di fan-out.

 $V_{dd} = 3.5 \text{ V}, V_{T} = 0.4 \text{ V}.$

Esame di ELETTRONICA AB (mod. B): svolgere l'esercizio 1 (tempo disponibile 1h 15m). Esame di ELETTRONICA DEI SISTEMI DIGITALI A: l'esercizio 2 (tempo disponibile 1h 15m). Esame di FONDAMENTI DI ELETTRONICA A: svolgere gli esercizi 1 e 2 (tempo disponibile 2h).

L'elaborato deve essere contenuto in un unico foglio (4 facciate) protocollo

[•] Indicare su ciascun foglio nome, cognome, data e numero di matricola

[•] Non usare penne o matite rosse

Osservazioni preliminari.

- i) M2 è schiavo di M1, quindi può essere ON solo se M1 è ON. Non vale invece il viceversa: M1 può essere ON (vi>vtn) senza che M2 sia ON.
- ii) M2 quando ON (Vgs2=vx-vu>vtn) è sempre saturo (sse vx<vdd+vtn, sempre verificata).
- iii) Si osservi che vx è data dal partitore resistivo: vx=(vu*R1+vdd*R2)/(R1+R2). M2 è OFF quando vxvu<vtn, da cui è si ricava che M2 è OFF quando vu>2.75V.

Regione 1: vi<vtn, allora M1 OFF, quindi M2 OFF.

vu=vdd e vx=vdd, e vi<vtn). In questa regione dvu/dvi=0, quindi non ci sono punti notevoli.

Si rimane in regione 1 fintantochè M1 non va ON, ovvero per vi>vtn.

Regione 2: vi>vtn, allora M1 ON sat, M2 OFF.

Cerco se in questa regione esistono punti della caratteristica statica di trasferimento a pendenza –1 (cioè cerco i punti tali che dvu/dvi=-1).

ir=(vdd-vu)/(R1+R2)vi = 0.513, vu = 3.493V.

 $idn1sat=\beta_{n1}/2*(vi-vtn)^2$ Tale coppia di valori soddisfa l'Hp di saturazione di M1: vu $d(idn1sat)/dvi=\beta_{n1}*(vi-vtn)$ (=3.493) > vi-vtn (=0.013 V), e di spegnimento di M2 Ma idn1sat=ir (vu>2.75V).

e d(idn1sat)/dvi=1/(R1+R2)Ouindi:

Risolvendo si ricava la seguente coppia di valori V_{0HMIN}=3.493 V, e V_{ILMAX}=0.513 V.

(vi, vu):

Passaggio dalla Regione 2 alla Regione 3: stato dei transistori.

Possono accadere due cose distinte: M2 va ON (e quindi è sat), oppure prima che ciò accada M1 cambia regione portandosi in zona lineare. Si deve verificare quale condizione avviene prima.

Si è già ricavato che M2 rimane OFF fintantoché prima che M1 vada LIN.

Vu>2.75 V.

OFF si ricava dalle equazioni seguenti:

 $idn1lin=\beta_{n1}*((vi-vtn)*vu-1/2*vu^2)$

ir=(vdd-vu)/(R1+R2)

vi=vu+vtn

Ma idn1lin=ir

da cui si ricavano le seguenti coppie di valori:

vi=0.181 V, vu=-0.319 V,(soluzione non accettabile),

e vi=0.792 V, vu=0.292 V.

Poiché vu sta calando, vu raggiunge prima il valore di

2.75V che non 0.292V, quindi M2 si accende

Se si vuole calcolare il valore di vi per il quale Il valore di vi e vu per i quali M1 diventa LIN con M2 vu=2.75 V con M1 SAT, e M2 sulla soglia, ma è già sufficiente quanto appena detto per l'analisi delle regioni di funzionamento dei transistori, si può

ricavare dalle equazioni seguenti:

vu = 2.75 V

 $idn1sat=\beta_{n1}/2*(vi-vtn)^2$ ir=(vdd-vu)/(R1+R2)

idn1sat=ir

dove vx-vu=vtn, che porta ad avere vi=0.641 V e

(vi=-0.359V, non accettabile). Quindi per vi=0.641V,

vu=2.75 V M2 va ON.

Regione 3: M1 SAT, M2 SAT

Cerco se in questa regione esistono punti della caratteristica statica di trasferimento a pendenza –1 (cioè cerco i punti tali che dvu/dvi=-1).

vx = (vu*R1+vdd*R2)/(R1+R2) $d(idn2sat)/dvi=\beta_{n2}*(vx-vu-vtn)*(-R1/(R1+R2)+1)$

ir=(vdd-vu)/(R1+R2)Ma idn1sat=ir+idn2sat

 $idn1sat=\beta_{n1}/2*(vi-vtn)^2$ d(idn1sat)/dvi=1/(R1+R2)+d(idn2sat)/dvi,

 $idn2sat=\beta_{n2}/2*(vx-vu-vtn)^2$ $vi=0.5-0.027^{TM}, vu=3.05+0.614^{TM}$ $d(idn1sat)/dvi=\beta_{n1}*(vi-vtn)$ $vi=0.5+0.027^{TM}, vu=3.05-0.614^{TM}$.

In questa regione non esistono punti a pendenza -1.

Regione 4:M1 LIN, M2 SAT.

Cerco se in questa regione esistono punti della caratteristica statica di trasferimento a pendenza -1 (cioè cerco i punti tali che dvu/dvi=-1).

 $\overline{vx = (vu*R1 + vdd*R2)/(R1+R2)}$ $vi=1.132 \text{ V} = V_{IHMIN}, vu=0.376 = V_{OLMAX}$ ir=(vdd-vu)/(R1+R2)La soluzione accettabile è la seconda. La hp di

 $idn1lin=\beta_{n1}*((vi-vtn)*vu-1/2*vu^2)$ linearità di M1 è verificata (vu=(0.376 V)<vi
$$\begin{split} &idn2sat=\beta_{n2}/2*(vx-vu-vtn)^2\\ &d(idn1lin)/dvi=\beta_{n1}*(vu+(vi-vtn)*-1+vu)\\ &d(idn2sat)/dvi=\beta_{n2}*(vx-vu-vtn)*(-R1/(R1+R2)+1)\\ &idn1lin=ir+idn2sat\\ &d(idn1lin)/dvi=1/(R1+R2)+d(idn2sat)/dvi\\ &da~cui~si~ricavano~le~seguenti~coppie~di~valori~(vi,vu):\\ &vi=-0.403~V~,vu=-0.376~V \end{split}$$

vtn(=0.632 V)), e di accensione di M2 (vu<2.75 V). Si ricava allora che: (* V_{ILMAX} - V_{OLMAX} *) NM_L=0.513 V-0.376 V=0.137 V=**NM** (* V_{OHMIN} - V_{IHMIN} *) NM_H=3.493 V-1.132 V=2.361V

